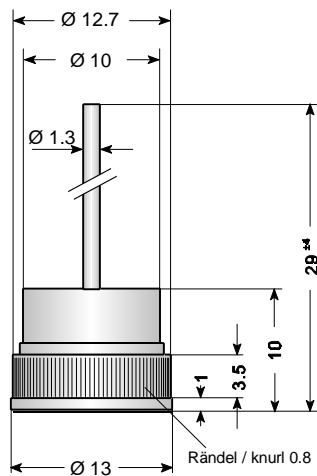


Silicon Press-Fit-Z-Diodes
High-temperature diodes
Silizium-Einpreß-Z-Dioden
Hochtemperaturdioden


Dimensions / Maße in mm

 Power dissipation – Verlustleistung 50 W

 Standard tolerance of Z-voltage $\pm 10\%$ (E12)

Standard-Toleranz der Arbeitsspannung

 Metal press-fit case with plastic cover
 Metall-Einpreßgehäuse mit Plastik-Abdeckung

 Weight approx. – Gewicht ca. 10 g

 Casting compound has UL classification 94V-0
 Vergußmasse UL94V-0 klassifiziert

Standard: Cathode to case / am Gehäuse

Index R: Anode to case / am Gehäuse (e.g. BYZ50A22R)

Standard packaging: bulk

Standard Lieferform: lose im Karton

Maximum ratings
Grenzwerte

Type / Typ	Zener voltage ¹⁾ Arbeitsspannung ¹⁾ $I_Z = 100\text{mA}$ V_Z [V]	Dynamic resistance Diff. Widerstand $f=1\text{kHz}, I_Z=100\text{mA}$ r_{zj} [Ω]	Max. Z-current ²⁾ Max. Arbeitsstrom ²⁾ $T_A = 50^\circ\text{C}$ I_Z [mA]
BYZ 50A22	19.6...24.4	2.5	2040
BYZ 50A27	24.1...30.0	2.8	1600
BYZ 50A33	29.6...36.5	3.2	1360
BYZ 50A39	35.5...43.5	4	1140
BYZ 50A47	42...52	4.5	960

 Max. average forward rectified current, R-load $T_C = 150^\circ\text{C}$ I_{FAV} 50 A
 Dauergrenzstrom in Einwegschtung mit R-Last

 Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur T_j $-50\dots+215^\circ\text{C}$
 Storage temperature – Lagerungstemperatur T_s $-50\dots+215^\circ\text{C}$

 Maximum pressure – Maximaler Einpreßdruck 7 kN

 Thermal resistance junction to case R_{thc} $< 0.6\text{ K/W}$
 Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse

¹⁾ Tested with pulses – Gemessen mit Impulsen

²⁾ Valid, if the temp. of the case is kept to 150°C – Gültig, wenn die Gehäusetemp. auf 150°C gehalten wird